# NEW POLYMER AND LUMINESCENT ELEMENT USING THE SAME

Patent number:

JP2002363227

**Publication date:** 

2002-12-18

Inventor:

TAGUCHI TOSHIKI

**Applicant:** 

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

C08F226/06; C09K11/06; H05B33/14; C08F226/00; C09K11/06; H05B33/14; (IPC1-7): C08F226/06;

C09K11/06; H05B33/14

- european:

Application number: JP20020096637 20020329

Priority number(s): JP20020096637 20020329; JP20010104579 20010403

Report a data error here

#### Abstract of JP2002363227

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain both a new polymer and a luminescent element which contains the polymer and has high luminance emission and high luminous efficiency and excellent durability. SOLUTION: The polymer is represented by the formula (1) (Am )p -(Bn )q -(Ck )r (A is a monomer unit containing pyrrole, thiophene, furan and its aromatic and heteroaromatic condensed ring derivatives; B is a monomer unit containing a heterocyclic derivative containing two or more hetero atoms on one ring system; C is a monomer unit containing a structure except those of B and C; (m) and (n) are each an integer of >=1; (k) is an integer of >=0; (p) and (q) are each a mol fraction (%) and are each 1-99; (r) is 0-98(%), p+q+5=100(%); at least one monomer unit of A, B and C is substituted with a >=4C ballast group).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

## (19)日本国特許庁 (IP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開2002-363227

(P2002-363227A) (43)公開日 平成14年12月18日(2002.12.18)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI		テーマコート	(参考)
C08F226/06	19473 - HO - 3	C08F226/06		3K007	
C09K 11/06	690	C09K 11/06	690	4J100	
H05B 33/14		H05B 33/14		В	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全18頁)

(21) 出願番号 特願2002-96637 (P2002-96637) (22) 出願日 平成14年3月29日(2002.3.29)

(31)優先権主張番号 特願2001-104579(P2001-104579)

平成13年4月3日(2001.4.3)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 田口 敏樹

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 DB03

4J100 AB02R AB07Q AB07R AL05R
AQ26P AQ26Q BC43Q BC43R
BC79Q BC79R BC83Q BC83R
CA04 CA05 DA61 JA32 JA43

### (54) 【発明の名称】新規ポリマーおよびそれを用いた発光素子

#### (57)【要約】

(32)優先日

【課題】 新規ポリマーおよび該ポリマーを含有した高輝度発光および高発光効率、耐久性に優れる発光素子を提供する。

【解決手段】下式(1)で表されるポリマーおよびそれを含有する発光素子。

#### 【化1】

 $(A_m)_p$  —  $(B_n)_q$  —  $(C_k)_r$  — 般式(1)

(式中、Aはピロール、チオフェン、フランならびにその芳香族およびヘテロ芳香族縮合環誘導体を含むモノマーユニットを表す。Bは1つの環系に2つ以上のヘテロ原子を含有するヘテロ環誘導体を含むモノマーユニットを表す。Cはそれ以外の構造を有するモノマーユニットを表す。m,nは1以上の整数を表し、kは0以上の整数を表す。p及びqはそれぞれモル分率(%)で、1~99(%)を表し、rは0~98(%)を表す。p+q+r=100(%)である。A,B,Cの少なくとも1つのモノマーユニット中には、炭素数4以上のバラスト基が置換されている。)

30

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表されるポリマー。 【化1】

#### 一般式 (1) $(A_m)_p$ — $(B_n)_q$ — $(C_k)_r$

(式中、Aは、ピロール、チオフェン、フラン、インド ール、カルバゾール、ジベンゾチオフェン、ベンゾフラ ン、ジベンゾフランのいずれかから選ばれる少なくとも 一つを含むモノマーユニットを表す。Bは、イミダゾー ル、ピラゾール、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、 オキサゾール、チアゾール、イソオキサゾール、イソチ 10 ると、ORGANIC ELECTROLUMINESCENT MATERIALS AND DEV アゾール、トリアゾール、テトラゾール、オキサジアゾ ールおよびチアジアゾールのいずれかから選ばれる少な くとも一つを含むモノマーユニットを表す。Cはそれ以 外の構造を有するモノマーユニットを表す。m,nは1以 上の整数を表し、kはO以上の整数を表す。p, q, rはそれ ぞれモル分率 (%) で、p及びqは1~99 (%) を表 し、rは0~98(%)を表す。p+q+r=100(%) である。A. B, Cの少なくとも1つのモノマーユニッ ト中には、炭素数4以上20以下の、アルキル基、アル コキシ基、エステル基、アミド基、スルホンアミド基の 20 いずれかから選ばれる少なくとも一つが置換されてい る。)

【請求項2】 一般式(1)中のAの少なくとも1つが カルバゾール骨格を含むモノマーユニットであり、Bの 少なくとも 1 つが1, 3, 4-オキサジアゾール骨格を含むモ ノマーユニットであることを特徴とする請求項1に記載 のポリマー。

【請求項3】 一般式(1)中のA, B, 及びCの各々 がビニルモノマーユニットであることを特徴とする請求 項1または2に記載のポリマー。

【請求項4】 陽極、陰極間に、少なくとも1種のポリ マーを含有する層を有する発光素子であって、該ポリマ ーの少なくとも1種が請求項1~3のいずれかに記載の ポリマーであることを特徴とする発光素子。

【請求項5】 前記ポリマーを含有する層が、三重項励 起子からの発光が可能な発光材料を、少なくとも1種含 有することを特徴とする請求項4に記載の発光素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規ポリマー、及 40 び該ポリマーを含有した高輝度発光および高発光効率、 耐久性に優れる発光素子、特に有機発光素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも、有機エレクトロルミネッセンス (EL)素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができ、 有望な表示素子として注目されている。例えば、有機化 合物の蒸着により有機薄膜を形成するEL素子が知られて いる(Applied Physics Letters, 51, p. 913~, (1987))。 該文献記載の有機EL素子は電子輸送材料と正孔輸送材料 50

の積層構造を有し、従来の単層型素子に比べてその発光 特性が大幅に向上している。

【0003】この積層型素子では、素子材料として低分 子有機材料を蒸着することにより素子を形成している。 有機EL素子に用いられているような薄膜を形成する技術 としては、上記の文献にあるような真空蒸着法、スパッ タ法、CVD、PVD、溶剤を用いた塗布法等、種々の方法を 使用することができる。この詳細については、いくつか の成書にもその内容が記述されている。その一例を挙げ ICES (OPA, Amsterdam, 1997)、有機EL素子とその工業化 最前線 (エヌ・ティー・エス, 1998) 等がある。 発明者 は薄膜形成技術として、有機化合物、特に有機高分子材 料を溶液塗布する方法について検討を行ってきた。有機 高分子材料の場合、素材単独で欠陥の少ない薄膜を形成 することが可能であり、形成された薄膜の物理的、化学 的堅牢性にも優れるという特徴を有する。

【0004】しかしながら、電子輸送性、電子注入性、 正孔輸送性、正孔注入性、発光性など種々の機能を有す る材料を複数発光素子に使用する場合、有機高分子材料 では、混合時に相分離などが起きることが多く、性能に 問題のあることがわかった。また、低分子化合物をポリ マー材料と混合して使用した場合でも、耐久性の面で問 題があることがわかってきた。

【0005】特開2000-286056号には、カルバゾール誘 導体を含む有機発光素子材料が開示されている。特開平 9-255725号には、オキサジアゾール基含有高分子を有機 発光素子の電子輸送材料として用いており、カルバゾー ル誘導体との共重合体を開示しているのみである。

【0006】上記の欠点を改良する試みとして、種々の 機能を有するモノマー同士を共重合する方法が考えられ るが、発明者がこの方法を種々検討してみたところ、単 純な共重合体では十分な性能が得られないことがわかっ

【0007】一般に発光素子では、正孔輸送性化合物と 電子輸送性化合物を積層もしくは同一層に使用して、発 光効率を向上させることが可能である。発明者は、塗布 型有機EL素子において材料を複数使用する素子の検討を 行ってきた。塗布型の発光素子に使用する発光素子材料 としては、正孔輸送性化合物としてピロール、チオフェ ン、フランなどの電子過剰性ヘテロ芳香族化合物が有効 である。また、電子輸送性化合物としてはヘテロ含子を 複数含む電子欠損性ヘテロ芳香族化合物が有効である。 しかしながら、先述の通り、複数の機能性材料を発光素 子に使用する場合、有機高分子材料同士では、低い発光 性能しか得られないことがわかった。また、低分子化合 物をポリマー材料と混合して使用した場合には、耐久性 の面で問題があることがわかった。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、第1

に新規なポリマーを開発することにある。そして第2 に、それを使用した高輝度で、かつ良好な発光効率で発 光し、耐久性に優れた発光素子を開発することにある。 [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記に記載の ポリマーおよび発光素子によって達成された。

1. 下記一般式(1)で表されるポリマー。

[0010]

【化2】

 $(A_n)_p$ — $(B_n)_q$ — $(C_k)_r$ 一般式(1)

【0011】(式中、Aは、インドール、カルバゾー ル、ジベンゾチオフェン、ベンゾフラン、ジベンゾフラ ンのいずれかから選ばれる少なくとも一つを含むモノマ ーユニットを表す。Bは、イミダゾール、ピラゾール、 ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、オキサゾール、チ アゾール、イソオキサゾール、イソチアゾール、トリア ゾール、テトラソール、オキサジアゾールおよびチアジ アゾールのいずれかから選ばれる少なくとも一つを含む モノマーユニットを表す。Bは、イミダゾール、ピラゾ ール、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、オキサゾー 20 れる数値を、それぞれ最小値および最大値として含む範 ル、チアゾール、イソオキサゾール、イソチアゾール、 トリアゾール、テトラゾール、オキサジアゾールおよび チアジアゾールのいずれかから選ばれる少なくとも一つ を含むモノマーユニットを表す。Cはそれ以外の構造を 有するモノマーユニットを表す。m,nは1以上の整数を 表し、kは0以上の整数を表す。p,q,rはそれぞれモル分 率 (%) を意味し、p及びqは1~99(%) を表し、r は0~98 (%) を表す。p+q+r=100 (%) であ る。A、B、Cの少なくとも1つのモノマーユニット中 には、炭素数4以上20以下の、アルキル基、アルコキ 30 シ基、エステル基、アミド基、スルホンアミド基のいず れかから選ばれる少なくとも一つが置換されている。) 2. 一般式(1)中のAの少なくとも1つがカルバゾ ール骨格を含むモノマーユニットであり、Bの少なくと も1つが1,3,4-オキサジアゾール骨格を含むモノマーユ ニットであることを特徴とする前記1に記載のポリマ -.

- 一般式(1)中のA, B, 及びCの各々がビニル モノマーユニットであることを特徴とする前記1または 2に記載のポリマー。
- 4. 一般式(1)で表されるポリマーが下記一般式 (2) で表されるポリマーであることを特徴とする前記 1~3のいずれかに記載のポリマー。

[0012]

[化3]

一般式(2)

$$\frac{-\left(-CH-CH_{2}\right)_{X}}{A'}\left(-CH-CH_{2}-\right)_{y}\left(-CH-CH_{2}-\right)_{z}$$

【0013】(式中、A'はカルバゾールを表し、主鎖 と1位から9位のいずれに結合してもよい。B'は1,3, 4-オキサジアゾール骨格を含む部分構造であり、C'は A'及びB'以外の構造を有するモノマーユニットを表 す。x、y、及びzは各々モル分率(%)を表し、x、 及びyは1~99 (%) を表し、rは0~98 (%) を 表し、p+q+r=100 (%) である。A', B', C' の少なくとも1つに炭素数4以上のバラスト基が置換さ れている。)

陽極、陰極間に、少なくとも1種の 10 【0014】5. ポリマーを含有する層を有する発光素子であって、該ポ リマーの少なくとも1種が前記1~4のいずれかに記載 のポリマーを含有することを特徴とする発光素子。

発光材料として三重項励起子からの発光が可能な 発光材料を、少なくとも1種使用することを特徴とする 前記5に記載の発光素子。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。なお本明細書において「~」はその前後に記載さ 囲を示す。

【0016】はじめに一般式(1)で表されるポリマー について説明する(以下、本発明のポリマーと称す る)。該ポリマーは、A、B、Cの3つのモノマーユニ ットで構成されるが、rはO (p+q+r=100(%)) の場合があり、本発明のポリマーは、AとBのモノマー ユニットを主成分として必ず含有することに特徴があ る。なお、本発明におけるモノマーユニット(以下、本 発明のモノマーと称する)とは、繰り返し単位を意味す

【0017】一般式(1)で表されるポリマーにおい て、Aはピロール、チオフェン、フランならびにその芳 香族およびヘテロ芳香族縮合環誘導体を含むモノマーユ ニットを表す。ピロール、チオフェン、フランはπ電子 過剰ヘテロ芳香族環と称される一群の構造に属する化合 物群であり、本発明ではその誘導体を含むモノマーユニ ットを使用する。該誘導体としては、まずピロール、チ オフェン、フランのベンゾ縮合体(例えばインドール、 カルバゾール、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェ 40 ン、ベンゾフラン、ジベンゾフラン等)を挙げることが できる。その他にも、インドリジン、チエノチオフェ ン、チエノピロール、イソインドールなどを挙げること ができる。これらの中でも、本発明ではピロール誘導体 を含むモノマーユニットが好ましく、特にカルバゾール が好ましく使用される。

【0018】Bは1つの環系に2つ以上のヘテロ原子を 含有するヘテロ環誘導体を含むモノマーユニットを表 す。このようなヘテロ環としては、イミダゾール、ピラ ゾール、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、オキサゾ 50 ール、チアゾール、イソオキサゾール、イソチアゾー

ル、トリアゾール、テトラゾール、オキサジアゾール、 チアジアゾール等、およびその縮合環を挙げることがで きる。本発明ではこの中でも特に1,3,4-オキサジアゾー ル誘導体が好ましく使用される。

【0019】CはA、B以外の構造を有するモノマーユ ニットを表す。ポリマーを形成する際のモノマーユニッ トの重合様式はビニル重合、縮重合、開環重合、アリー ルカップリング重合等、種々の重合反応によるポリマー 形成を行うことができるが、本発明では特にビニル重合 モノマーの重合によるポリマー形成反応が好ましい。C 10 のモノマーユニットとしても、ビニル重合モノマー(例 えばスチレン、アクリル酸エステル、メタクリル酸エス テル、ビニルエーテル、置換アリル等)が好ましい。

【0020】本発明のポリマーでは、A、B、Cの少な くとも1つのモノマーユニット中に、炭素数4以上のバ ラスト基が置換されているものが好ましく用いられる。 バラスト基とは、炭素数4以上の油溶性基のことを表 し、本発明のポリマーを非ハロゲン系、ハロゲン系など 種々の有機溶媒に可溶化させるために導入される。該バ ラスト基としては、アルキル基、アルコキシ基、エステ 20 ル基、アミド基、スルホンアミド基等を挙げることがで き、アルキル基、アルコキシ基(一OR; Rは炭素数4 以上のアルキル基)、エステル基(一COOR; Rは炭 素数3以上のアルキル基)が好ましく、アルキル基がよ り好ましい。また、これらが2つ以上の結合手を持ち、 連結している場合も含まれる。本発明で使用されるバラ スト基として好ましくはアルキル基、アルコキシ基であ り、その炭素数は4以上、好ましくは8以上20以下で あって、直鎖状および分岐のいずれも使用可能である。

【0021】本発明のポリマーは、バラスト基を有する 30 ために、ハロゲン系溶剤のみならずトルエンなどの非ハ ロゲン系溶剤に溶解することができる。しかしバラスト 基を有しないカルバゾール系ポリマーは非ハロゲン系溶 剤への溶解性が低いために膜形成が困難であり、発光素 子の発光面から均一な発光ができない等の問題が発生す る。オゾン層破壊に作用しうる溶媒である、非ハロゲン 系溶剤を用いない製造方法が選択できる。以上の理由か ら、本発明の発光素子は、膜形成が良好なために発光輝 度、発光効率、及び耐久性に優れる。

【0022】一般式 (1) 中、m,nは1以上の整数を表 し、kはO以上の整数を表す。p及びqはそれぞれモル分 率 (%) で、1~99 (%) を表し、rは0~98

(%) を表す。p+q+r=100(%) である。mとして 好ましくは1~3、nとして好ましくは1~3、kとして 好ましくは0~2であり、さらに好ましくはカカが1~2、  $nが1\sim2$ 、kが0である。pとして好ましくは $20\sim9$ 5、qとして好ましくは1~50、rとして好ましくは0 ~40であり、さらに好ましくはpが50~95、qが5 ~50、rが0である。

基としての機能のもの以外にも種々の置換基が置換可能 である。その例を以下に列挙する。ハロゲン原子(例え ばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シ アノ基、ホルミル基、もしくは置換あるいは無置換のア ルキル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭 素数1~15である。例えば、メチル基、 t ーブチル基、 シクロヘキシル基などが挙げられる。)、アルケニル基 (好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~15 である。例えば、ビニル基、1-プロペニル基、1-ブテン -2-イル基、シクロヘキセン-1-イル基などが挙げられ る。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~30、より 好ましくは炭素数2~15である。例えばエチニル基、1-プロピニル基などが挙げられる。)、アリール基(好ま しくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~15であ る。例えば、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフ チル基、ビフェニリル基、ピレニル基などが挙げられ る。)、

հ

【0024】ヘテロ環基(好ましくは5または6員環で あり、他の環と縮合しても良い。ヘテロ原子としては、 例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子が挙げられる。好 ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~15であ る。例えば、ピリジル基、ピペリジル基、オキサゾリル 基、オキサジアゾリル基、テトラヒドロフリル基、チエ ニル基などが挙げられる。)、1~3級アミノ基(アミ ノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、ジアルキ ルアミノ基、ジアリールアミノ基、アルキルアリールア ミノ基、ヘテロ環アミノ基、ビスヘテロ環アミノ基な ど。好ましくは3級アミノ基であり、炭素数1~30、よ り好ましくは炭素数1~16である。例えばジメチルアミ ノ基、ジフェニルアミノ基、フェニルナフチルアミノ基 などが挙げられる。)、イミノ基(-CR,,=NR,っまたは-N =CR, , R, , で表される基。ここでR, , ~R, , は水素原子、ア ルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基、ア リールオキシ基、1~3級アミノ基から選ばれる基であ る。好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~ 15である。)、

【0025】アルコキシ基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~15である。例えば、メトキシ 基、エトキシ基、シクロヘキシルオキシ基などが挙げら 40 れる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~3 0、より好ましくは炭素数6~15である。例えば、フェノ キシ基、1-ナフトキシ基、4-フェニルフェノキシ基シな どが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ましくは炭素 数1~30、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、 メチルチオ基、エチルチオ基、シクロヘキシルチオ基な どが挙げられる。)、アリールチオ基(好ましくは炭素 数6~30、より好ましくは炭素数6~15である。例えば、 フェニルチオ基、トリルチオ基などが挙げられる。) カ ルボンアミド基(好ましくは炭素数1~30、より好まし 【0023】本発明のモノマーユニットには、バラスト 50 くは炭素数1~15である。例えば、アセトアミド基、ベ

ンゾイルアミド基、N-メチルベンゾイルアミド基などが 挙げられる。)、スルホンアミド基(好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、メ タンスルホンアミド基、ベンゼンスルホンアミド基、p-トルエンスルホンアミド基などが挙げられる。)、カル バモイル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは 炭素数1~15である。例えば、無置換のカルバモイル 基、メチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基、 フェニルカルバモイル基、ジフェニルカルバモイル基、 ジオクチルカルバモイル基などが挙げられる。)、

【0026】スルファモイル基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、無置換 のスルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチ ルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基、ジフ ェニルスルファモイル基、ジオクチルスルファモイル基 などが挙げられる。)、アルキルカルボニル基(好まし くは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~15である。 例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチロイル基、 ラウロイル基などが挙げられる。)、アリールカルボニ ル基 (好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6 20 ~15である。例えば、ベンゾイル基、ナフトイル基など が挙げられる。)、アルキルスルホニル基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~15である。例え ば、メタンスルホニル基、エタンスルホニル基などが挙 げられる。)、アリールスルホニル基(好ましくは炭素 数6~30、より好ましくは炭素数6~15である。例えば、 ベンゼンスルホニル基、p-トルエンスルホニル基、1-ナ フタレンスルホニル基などが挙げられる。)、

【0027】アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素 数1~30、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、 メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキ シカルボニル基などが挙げられる。)、アリールオキシ カルボニル基(好ましくは炭素数6~30、より好ましく は炭素数6~15である。例えばフェノキシカルボニル 基、1-ナフトキシカルボニル基などが挙げられる。)、 アルキルカルボニルオキシ基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、アセト キシ基、プロピオニルオキシ基、ブチロイルオキシ基な どが挙げられる。)、アリールカルボニルオキシ基(好 ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~15であ 40 る。例えばベンゾイルオキシ基、1-ナフトイルオキシ基 などが挙げられる。)、ウレタン基(好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、メ トキシカルボンアミド基、フェノキシカルボンアミド 基、メチルアミノカルボンアミド基などが挙げられ る。)、ウレイド基(好ましくは炭素数1~30、より好

ましくは炭素数1~15である。例えば、メチルアミノカルボンアミド基、ジメチルアミノカルボンアミド基、ジフェニルアミノカルボンアミド基などが挙げられる。)、炭酸エステル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~15である。例えば、メトキシカルボニルオキシ基、フェノキシカルボニルオキシ基などが挙げられる。)などである。

【0028】前記一般式(1)は好ましくは下記一般式(2)である。

[0029]

【化4】

一般式 (2)

$$\begin{array}{c|c}
-(CH-CH_2)_{x} & CH-CH_2 \\
\downarrow \\
A' & B' & C'
\end{array}$$

【0031】前記一般式(2)中、A'はカルバゾールを表し、1位から9位のいずれに結合してもよいが、好ましくは9位(カルバゾールの窒素原子)と結合するのが好ましい。B'は1,3,4-オキサジアゾール骨格を含む部分構造であり、好ましくは

[0032]

【化5】

【0033】で表される部分構造である。また2は0が好ましい。バラスト基の好ましい範囲、及びバラスト基以外の置換基の好ましい範囲は、一般式(1)と同じ範囲である。

【0034】以下に好ましいモノマーユニットの具体例、それに続いて具体的な合成反応例をルートともに示すが、本発明はもちろんこれによって限定されるものではない。

[0035]

【化6】

[0036]

【化7】

12

11

B-1

B-2 C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

B-3

B-4 C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>

**B**-5

B-6

B-7

B-8

B-9 B-10

[0037] 【化8】

13 C-6 【0038】 (モノマーの具体的合成方法) C-1 [0039] CH<sub>3</sub> 【化9】 C-2 C-7 C-3 C-8 OC12H25 **C-4** C-9 C-10 C-5 Ç<sub>12</sub>H<sub>25</sub> C<sub>12</sub>H<sub>25</sub> C<sub>12</sub>H<sub>25</sub> сно X-2 X-1 **A-3** COOH СОИНИНСО Ċ<sub>8</sub>H<sub>17</sub> **B-2** Y-1 Y-2

【0040】1) モノマーA-3の合成 - を取り付けた1000mlの三つロフラスコにカルバゾール (化合物X-1の合成) 温度計とリフラックスコンデンサ 50 50.1g(0.3mol)、1-ブロモドデカン77g(0.31mol)、トル

エン250ml、水酸化カリウム18g(0.31mol)、テトラ-n-ブ チルアンモニウムブロミド5g、水100mlを仕込んだ。磁 気撹拌子を用いて内容物を撹拌しながら、還流条件下5 時間反応させた。反応終了後、水層を除き、トルエン層 を200mlの水で2回洗浄した。水層を除き、トルエン層 を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過の後、濾液を減 圧下、溶媒を留去すると固形物が析出した。この結晶を エタノールから再結晶して化合物X-1の結晶92gを得た。 【OO41】(化合物X-2の合成)温度計とリフラック スコンデンサーを取り付けた1000mlの三つ口フラスコ に、N, N-ジメチルホルムアミド(DMF) 150mlを仕込み、磁 気撹拌子を用いて撹拌しながら、ここに氷ーメタノール 浴を取り付け、内温を-10℃まで低下させた。ここに、 オキシ塩化リン 47g(0.3mol)を内温が0℃を越えないよ うに徐々に滴下した。滴下終了後さらにこの状態で15 分ほど撹拌を続けた。その後ここに化合物X-1の結晶101 g(0.3mol)を200mlのDMFに溶解した溶液を10分かけて 徐々に滴下した。滴下終了後、室温条件下30分ほど撹 拌しながら反応させ、さらに湯浴を取り付け、80℃ま で温度を上昇させてさらに3時間反応させた。反応終了 20 後、反応混合物を冷水3リットルに注ぎ入れると結晶が 析出した。この結晶を濾別し、エタノール・水の混合溶 媒から再結晶して、化合物X-2の結晶97gを得た。

【0042】(モノマーA-3の合成)温度計とリフラッ クスコンデンサーを取り付けた1000mlの三つ口フラスコ に、化合物X-2 72.6g(0.2mol)、重合禁止剤として、2, 6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール5g、トリフェニルメ チルホスホニウムブロミド71.5g(0.2mol)、N,N-ジメチ ルホルムアミド(DMF)400mlを仕込み、磁気撹拌子を用い て撹拌しながら、ここに氷ーメタノール浴を取り付け、 内温を0℃まで低下させた。ここに、28質量%ナトリウム メトキシドのメタノール溶液0.2mol相当を10分かけて 滴下した。滴下終了後、冷却浴をはずして室温条件と し、さらにこの状態で3時間ほど撹拌を続けた。反応終 了後、反応混合物を冷水3リットルに注ぎ入れると結晶 が析出した。この結晶を濾別し、シリカゲルカラムクロ マトグラフィーを用いてn-ヘキサン/酢酸エチル=4/1の 体積混合比の溶出液を用いて分離を行い、モノマーAー 3の結晶66gを得た。

#### 【0043】2) モノマーB-2の合成

(化合物Y-1の合成) 温度計とリフラックスコンデンサ ーを取り付けた1000mlの三つ口フラスコに4-オクチル安 息香酸117g (0.5mol)、酢酸エチル400ml、触媒としてD MF1滴を仕込み、磁気撹拌子を用いて内容物を撹拌しな がら、湯浴を用いて内温50℃に保った。ここに、オキザ リルクロリド127g (1.0mol) を徐々に滴下すると、激し くガスを発生しながら反応が起こった。滴下終了後、さ らにこの温度で反応を続け、2時間ほど反応させるとガ スの発生がほとんど認められなくなった。リフラックス コンデンサーをはずし、トラップを介した減圧蒸留用の 50 ないものについては、100%すなわち1を意味する。

器具を取り付け、アスピレーターを用いて揮発成分をす べて留去させた。このようにして4-オクチルベンゾイル クロリドを合成した。これとは別に、温度計とリフラッ クスコンデンサーを取り付けた2000m1の三つ口フラスコ に、4-ブロモベンズヒドラジド107.6g (0.5mol)、N,N-ジメチルアセトアミド800mlを仕込んだ。磁気撹拌子を 用いて内容物を撹拌しながら、ここに氷ーメタノール浴 を取り付け、内温を0℃まで低下させた。ここに、上記 で合成した4-オクチルベンゾイルクロリドの全量を内温 10 が20℃を越えないように徐々に滴下した。反応は発熱的 に瞬時に起こり、不溶性の白色結晶が析出した。滴下終 了後、室温でさらに30分反応させた。反応終了後、ア セトニトリル600mlを加えて生成物の結晶を完全に析出 させた。析出した結晶を、ヌッチェを用いて減圧下濾別 した。この結晶をアセトニトリルで洗浄して、化合物Y-1の結晶201gを得た。

【0044】(化合物Y-2の合成)温度計とリフラック スコンデンサーを取り付けた2000mlの三つ口フラスコ に、化合物Y-1の結晶200g、ポリリン酸1000gを仕込み、 油浴を用いて加熱した。始め内容物は粘稠だが、内温が 100℃を越えるあたりから流動性を持つようになる。こ の混合物を、撹拌バネを用いて撹拌しながら、内温160 ~180℃の条件下 5 時間反応させた。反応終了後、内温 が100℃付近まで低下したところで、内容物を冷水に加 えた。温度が上昇するとともに、白色結晶が析出した。 この結晶をエタノールから再結晶して、化合物Y-2の結 晶159gを得た。

【0045】(モノマーB-2の合成)温度計とリフラッ クスコンデンサーを取り付けた2000m1の三つ口フラスコ 30 に、化合物Y-2 124g(0.3mol)、重合禁止剤として、2,6 -ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール7g、トリフェニルホ スフィンlg、10質量%パラジウム担持活性炭素触媒5g、 4-フェニルボロン酸74g (0.5mol) 、炭酸ナトリウム106 g (1.0mol) 、ジエチレングリコールジメチルエーテル5 00ml、水100mlを仕込み、撹拌バネを用いて撹拌しなが ら、還流条件下5時間反応させた。反応終了後、ここに ジエチレングリコールジメチルエーテル500mlをさらに 加え、熱時セライトを敷いたヌッチェを用いて減圧濾過 することにより、触媒を濾別した。濾液にメタノール1 リットルを加えると生成物の結晶が析出するので、冷却 後これを濾別した。この粗結晶を酢酸エチル/エタノー ルの混合溶媒から再結晶して、モノマーB-2の結晶12 7gを得た。

【0046】さらに上記モノマーの重合反応により形成 されるポリマー化合物(本発明に好ましく使用されるポ リマー)の具体例を以下に例示する。この具体例によっ て、本発明はもちろん限定されるものではない。下記に 示される化学構造式中において、ポリマー主鎖部分の括 弧右下の数字はモル分率 (%) を意味し、明記されてい [0047]

【化10】 P-5 CH-CH2-)20 -ÇH-CH<sub>2</sub>-)<sub>90</sub> (-ÇH-CH<sub>2</sub>-)<sub>10</sub> ÇH-СН₂<del>-)во</del>-<del>--(-</del>Сн-Сн<sub>2</sub>-) -ÇH-CH<sub>2</sub>-)<sub>в5</sub> --(-ÇH-CH<sub>2</sub>-)<sub>15</sub> CH-CH2-) (- CH-CH2-)15 ÇH-CH₂<del>)</del> ÇН-СН₂<del>-) во</del> <del>-(-</del>çн-сн<sub>2</sub>-)<sub>20</sub>

[0048]

【化11】

[0049]

【化12】

P-13 
$$CH_2$$
  $CH_2$   $CH$ 

【0050】(ポリマーの具体的合成方法)

【化13】

[0051]

【0052】 (ポリマーP-1の合成) 温度計、ガス導入 管とリフラックスコンデンサーを取り付けた500mlの三 つ口フラスコに、N-ビニルカルバゾール15.5g(0.08mo 1) 、モノマーB-2 8.72g (0.02mol)、トルエン150ml 20 を仕込み、窒素気流を通じた。磁気撹拌子を用いて内容 物を撹拌しながら、内温を70℃にコントロールした。こ こに開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを0.1gず つ、1時間おきに5回添加した。添加終了後さらに3時 間重合反応を続けると、TLCプレートのチェックでモノ マーはすべて消失しているのが確認された。このポリマ 一溶液を濾過後、3リットルのメタノール中に投入して ポリマーの沈殿精製を行い、析出したポリマーを濾別、 乾燥した。このようにして、ポリマーP-5をフレーク状 の固体として、22.9g得た。

【0053】本発明に使用することができるポリマー は、重合法として、ラジカル重合、イオン重合、縮重 合、開環重合などの重合方法によってポリマーに誘導可 能である。中でもラジカル重合やイオン重合のような、 ビニル重合により得られたポリマーが好ましく使用され る。これら重合法については、「高分子合成の実験法」 大津・木下共著 化学同人刊(1972)に詳細が記載されて いる。合成により生成するポリマーの質量平均分子量(M w)としては、1000~10000000、好ましくは2000~100000 0、特に好ましくは5000~500000である。また、本発明 のポリマーは、もちろん他の有機素材や無機素材と併用 して有機発光素子材料として使用可能である。併用する 有機素材としては低分子有機素材でもポリマーでもよ

【0054】本発明のモノマーから合成されるポリマー は有機発光素子材料として、ホスト材料、正孔注入材 料、正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料、電子注入 材料いずれとしても使用可能であるが、ホスト材料と電 荷注入輸送材料の両機能を有する材料として用いるのが 好ましい。

【0055】本発明で使用するポリマーは、単独で使用 しても、他のポリマーと混合して使用してもよい。さら には、低分子化合物と混合して使用することも可能であ

【0056】本発明では、陽極、陰極間に1層以上、好 ましくは2層以上の発光素子材料を有する発光素子の製 造方法を与えるものである。その中でも、特に発光素子 材料として有機物を用いた有機発光素子の製造方法に関 する。本発明の方法では、少なくとも2層以上の素子材 料を塗設後、それに物理または化学的後処理を施すこと により、塗設された薄膜の素子材料を変性させ、発光素 子材料としての機能を向上させるものである。

【0057】本発明の発光素子に含有する材料として 30 は、正孔注入材料、正孔輸送性材料、正孔ブロッキング 材料、電子注入材料、電子輸送材料、電子ブロッキング 材料、発光材料等、発光素子材料として使用する材料で あればいずれのものでもよい。本発明では、上記種々の 発光素子材料として有機化合物を好ましく使用する。

【0058】本発明のポリマーを有機発光素子材料とし て使用する場合、有機発光素子としては発光材料が一重 項励起子から発光するもの、三重項励起子から発光する もの (りん光発光性化合物) 、両者から発光するもの、 いずれの発光材料においても使用可能であるが、特に三 重項励起子からの発光が含まれる発光材料との組み合わ せが、発光効率という観点から好ましく用いられる。

【0059】本発明で用いられる発光材料は、りん光発 光性化合物であるオルトメタル化金属錯体およびポルフ ィリン金属錯体の少なくとも一つが好ましく用いられ、 オルトメタル化金属錯体がより好ましく用いられる。

【0060】本発明で用いられるオルトメタル化金属錯 体について説明する。オルトメタル化金属錯体とは、例 えば「有機金属化学-基礎と応用ー」p150,232 裳華房社 山本明夫著 1982年発行、「Photochemis 50 try and Photophysics of Coordination Compounds p

71-p77, p135-p146 Springer-Verlag社 H. Yersin著19 87年発行等に記載されている化合物群の総称である。 前記金属錯体の中心金属としては、遷移金属であればい ずれも使用可能であるが、本発明では、中でもロジウ ム、白金、金、イリジウム、ルテニウム、パラジウム等 を好ましく用いることができる。この中でより好ましい ものはイリジウムである。前記オルトメタル化金属錯体 の具体的な記載および化合物例は、特願2000-254171号 公報の段落番号0152から0180までに記載されて いる。

【0061】オルトメタル化金属錯体の金属の価数は特 に限定しないが、イリジウムを用いる場合には3価が好 ましい。オルトメタル化金属錯体の配位子は、オルトメ タル化金属錯体を形成しうるものであれば特に問わな い。例えば、アリール基置換含窒素芳香族ヘテロ環誘導 体(アリール基の置換位置は含窒素芳香族へテロ環窒素 原子の隣接炭素上であり、アリール基としては例えばフ ェニル基、ナフチル基、アントラセニル基、ピレニル基 などが挙げられ、含窒素芳香族ヘテロ環としては、例え ば、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、キ 20 ノリン、イソキノリン、キノキサリン、フタラジン、キ ナゾリン、ナフチリジン、シンノリン、ペリミジン、フ ェナントロリン、ピロール、イミダゾール、ピラゾー ル、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、 チアジアゾール、ベンズイミダゾール、ベンズオキサゾ ール、ベンズチアゾール、フェナントリジンなどが挙げ られる)、

【0062】ヘテロアリール基置換含窒素芳香族ヘテロ 環誘導体(ヘテロアリール基の置換位置は含窒素芳香族 ヘテロ環窒素原子の隣接炭素上であり、ヘテロアリール 30 基としては例えば前記の含窒素芳香族へテロ環誘導体を 含有する基、チオフェニル基、フリル基などが挙げられ る)、7,8-ベンゾキノリン誘導体、ホスフィノアリ ール誘導体、ホスフィノヘテロアリール誘導体、ホスフ ィノキシアリール誘導体、ホスフィノキシヘテロアリー ル誘導体、アミノメチルアリール誘導体、アミノメチル ヘテロアリール誘導体等が挙げられる。このうちアリー ル基置換含窒素芳香族ヘテロ環誘導体、ヘテロアリール 基置換含窒素芳香族ヘテロ環誘導体、7,8-ベンゾキ ノリン誘導体が好ましく、フェニルピリジン誘導体、チ 40 オフェニルピリジン誘導体、7,8-ベンゾキノリン誘 導体がより好ましく、チオフェニルピリジン誘導体、 7,8-ベンゾキノリン誘導体が更に好ましい。

【0063】本発明に用いるポルフィリン金属錯体とし て好ましくは白金錯体であり、より好ましくは二価の白 金錯体である。

【0064】三重項励起子からの発光が観測される有機 発光素子としては、イリジウム錯体 (Ir(ppy),:Tris-Or tho-Metalated Complex of Iridium(III) with 2-Pheny

れている (Applied PhysicsLetters 75,4 (1999))。 本素子は外部量子収率8%を達しており、従来素子の限 界といわれていた外部量子収率5%を凌駕したことが報 告されている。

【0065】次に、本発明の化合物を含有する発光素子 に関して説明する。本発明の化合物を含有する発光素子 の有機層の形成方法は、特に限定されるものではない が、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子 積層法、コーティング法、インクジェット法などの方法 10 が用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティ ング法が好ましい。

【0066】本発明の発光素子は陽極、陰極の一対の電 極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄 膜(有機化合物層)を形成した素子であり、発光層のほ か正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層、 保護層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞ れ他の機能を備えたものであってもよい。各層の形成に はそれぞれ種々の材料を用いることができる。

【0067】本発明の発光素子は、一般式(1)で表さ れるポリマーを、少なくとも1種以上の該ポリマーを含 有する層を有する。本発明の発光素子を提供するには、 発光素子の有機化合物層において、該ポリマーを0.0 1~100質量%含有するのが好ましく、より好ましく は1~100質量%含有する。

【0068】陽極は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層 などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸 化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを 用いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の 材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化 インジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電性 金属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、髙導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは $50nm\sim1\mu$ mであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0069】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ lpyridine)からの発光を利用した緑色発光素子が報告さ 50 ラスを用いる場合には、通常 0.2 mm以上、好ましく

40

は0.7mm以上のものを用いる。

【0070】陽極の作製には材料によって種々の方法が 用いられるが、例えばITOの場合、電子ビーム法、ス パッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法(ゾルー ゲル法など)、酸化インジウムスズの分散物の塗布など の方法で膜形成される。陽極は洗浄その他の処理によ り、素子の駆動電圧を下げたり、発光効率を髙めること も可能である。例えばITOの場合、UV-オゾン処 理、プラズマ処理などが効果的である。

【0071】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層な 10 どに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送 層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の -材料としては金属、合金、金属ハロゲシ化物、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いる ことができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばし i、Na、K、Cs等)及びそのフッ化物、アルカリ土 類金属(例えばMg、Ca等)及びそのフッ化物、金、 銀、鉛、アルニウム、ナトリウムーカリウム合金または それらの混合金属、リチウムーアルミニウム合金または 20 それらの混合金属、マグネシウムー銀合金またはそれら の混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類金 属等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4 e V以下の材 料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムーア ルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウム 銀合金またはそれらの混合金属等である。

【0072】陰極は、上記化合物及び混合物の単層構造 だけでなく、上記化合物及び混合物を含む積層構造を取 ることもできる。陰極の膜厚は材料により適宜選択可能 であるが、通常10nm~5μmの範囲のものが好まし 30 く、より好ましくは50nm~1μmであり、更に好ま しくは100nm $\sim 1$  $\mu$ mである。

【0073】陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリ ング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が 用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を 同時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同 時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、ま たあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極及 び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω╱□以 下が好ましい。

【0074】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよい。好ましくは発光層に本発明のアミン化合物 を含有するものであるが、他の発光材料を用いることも できる。例えばベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミ ダゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベ 50 ト法など)が用いられる。コーティング法の場合、樹脂

ンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジ エン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタ ルイミド誘導体、クマリン誘導体、ペリレン誘導体、ペ リノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘 導体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、 ビススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導 体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導 体、シクロペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導 体、芳香族ジメチリディン化合物、8-キノリノール誘 導体の金属錯体や希土類錯体に代表される各種金属錯体 等、ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレン ビニレン等のポリマー化合物等が挙げられる。発光層の 膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 n m~5 μ mの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 n m~  $1 \mu m$ であり、更に好ましくは $10 nm \sim 500 nm$ で ある。

28

【0075】発光層の形成方法は、特に限定されるもの ではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリン グ、分子積層法、コーティング法(スピンコート法、キ ャスト法、ディップコート法など)、LB法、インクジ ェット法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加熱蒸 着、コーティング法である。

【0076】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、カルバゾール誘 導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキ サジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリー ルアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導 体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ (N-ビニルカルバゾール) 誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー等が挙げられる。正孔注入層、正 孔輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常 1 nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好ましく は5 n m~1 μ mであり、更に好ましくは10 n m~5 00nmである。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材 料の1種または2種以上からなる単層構造であってもよ いし、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構 造であってもよい。

【0077】正孔注入層、正孔輸送層の形成方法として は、真空蒸着法やLB法やインクジェット法、前記正孔 注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させてコーティング する方法 (スピンコート法、キャスト法、ディップコー 成分と共に溶解または分散することができ、樹脂成分と しては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポ リスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメ タクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェ ニレンオキシド、ポリブタジエン、ポリ(Nービニルカ ルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ 樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、A BS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエ ステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹 脂などが挙げられる。

【0078】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、トリアゾール誘 導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、 フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ア ントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピラン ジオキシド誘導体、カルビジイミド誘導体、フルオレニ リデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフ タレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フ 20 タロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯 体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベン ゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種 金属錯体等が挙げられる。電子注入層、電子輸送層の膜 厚は特に限定されるものではないが、通常1 n m~5 μ mの範囲のものが好ましく、より好ましくは5nm~1 μmであり、更に好ましくは10nm~500nmであ る。電子注入層、電子輸送層は上述した材料の1種また は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組 成または異種組成の複数層からなる多層構造であっても 30 よい。

【0079】電子注入層、電子輸送層の形成方法として は、真空蒸着法やLB法やインクジェット法、前記電子 注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させてコーティング する方法(スピンコート法、キャスト法、ディップコー ト法など)などが用いられる。コーティング法の場合、 樹脂成分と共に溶解または分散することができ、樹脂成 分としては例えば、正孔注入輸送層の場合に例示したも のが適用できる。

【0080】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, N i 等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2O3、G eO、NiO、CaO、BaO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、T i O<sub>2</sub>等の金属酸化物、MgF<sub>2</sub>、LiF、AlF<sub>3</sub>、C a F: 等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレ ア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフル オロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロ 50 らの素子の発光特性(表中では(初期)と明記)、なら

ロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレン との共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1 種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて 得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フ ッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率 0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。

【0081】保護層の形成方法についても特に限定はな く、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパ ッタリング法、MBE(分子線エピタキシ)法、クラス 10 ターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズ マ重合法(高周波励起イオンプレーティング法)、プラ ズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソ ースCVD法、コーティング法、インクジェット法を適 用できる。

#### [0082]

【実施例】以下に本発明の実施例について説明するが、 本発明はこれらにより限定されるものでない。 実施例1

25mm×25mm×0.7mmのガラス基板上にITOを150nmの厚さ で製膜したもの (東京三容真空 (株) 製) を透明支持基 板とした。この透明支持基板をエッチング、洗浄した。 この基板にポリ〔(3,4-エチレンジオキシ)-2,5-チオ フェン] ・ポリスチレンスルホン酸分散物 (Bayer社) 製:Baytron P 固形分1.3%) をスピンコートした後、 150℃ 2 時間真空乾燥して膜厚100nmの塗布層を形成し た。この上に発光層としてポリ(N-ビニルカルバゾール (PVK)) 40mg、PBD(2-(4'-t-ブチルフェニル)-5-(4''-(フェニル)フェニル)-1,3,4-オキサジアゾール)12mg、 発光材料としてクマリン-6 1mgを1,2-ジクロロエタン2m 1に溶解した溶液をスピンコートした。この塗布膜の膜 厚は約120nmであった。有機薄膜上にパターニングした マスク (発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、 蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を250nm共蒸着し た後、銀300nmを蒸着し、素子101を作製した。

【0083】上記で得られた素子の発光特性を、東陽テ クニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、直流 定電圧をEL素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン 社の輝度計BM-8、また発光波長については浜松ホトニク ス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定し 40 た。素子101の印可電圧19Vでの発光輝度は1500cd/m<sup>2</sup>、 さらに電圧を上昇させたときの最高輝度(Lmax)は3400cd ·/㎡であった。また、発光スペクトルを測定の上、その 全スペクトル領域の発光エネルギーを積分して得られた 値と、入力エネルギー値の比から換算した発光の外部量 子効率を評価したところ、入力エネルギーに対する最高 発光外部量子効率(Qexmax)は0.77%であった。

【0084】素子101に対して、表1に記載したように 発光層の発光材料、その他の素材を変更した以外は、10 1と全く同じ素子構成の素子102~123を作製した。これ

びに素子を窒素雰囲気下、60℃で1週間保存したあと 【表2】 の発光特性を評価した結果(表中では(保存)と明記) を表2に示す。

# [0085]

# 【表1】

累子 No. 101 (比較例)	発光材料	その他の素材
101 (比較例)		C -> 10 43 31(4)
	クマリン・6 1mg	PVK 40mg, PBD 12mg
102 (比較例)	クマリン-6 1mg	PVK 40mg, Q-1 12mg
103 (比較例)	クマリン-6 1mg	H-1 40mg, PBD 12mg
104 (比較例)	クマリン-6 1mg	Q-2 52mg
105 (本発明)	クマリン-6 1mg	P-1 52mg
106 (本発明)	クマリン-6 1mg	P-3 52mg
107 (本発明)	クマリン-6 1mg	P-4 52mg
108 (本発明)	クマリン-61mg	P-5 52mg
109 (本発明)	クマリン-61mg	P-8 52mg
110 (本発明)	クマリン-6 lmg	P-11 52mg
111 (比較例)	TL-1 1mg	PVK 40mg, PBD 12mg
112 (比較例)	TL-1 1mg	PVK 40mg, Q-1 12mg
113 (比較例)	TL-1 1mg	H-1 40mg, PBD 12mg
114 (比較例)	TL-1 1mg	Q-2 52mg
115 (比較例)	TL-1 1mg	Q-3 52mg
116 (比較例)	TL-1 lmg	Q-4 52mg
117 (本発明)	TL-I 1mg	P-1 52mg
118 (本発明)	TL-1 1mg	P-3 52mg
119 (本発明)	TL-1 1mg	P-4 52mg
120(本発明)	TL-1 1mg	P-5 52mg
121 (本発明)	TL-1 1mg	P-8 52mg
122(本発明)	TL-1 lmg	P-11 52mg
123(本発明)	TL-1 1mg	P-14 52mg

# [0086]

	Lmax	Оехшах	Lmax	Qexmax
素子 No.	(初期)	(初期)	(保存)	(保存)
JR 1 110.	(cd/m <sup>2</sup> )	(%)	(cd/m²)	(%)
101 (比較例)	3400	0.77	540	0.21
102 (比較例)	2500	0.56	520	0.20
103 (比較例)	1400	0.34	340	0.15
104 (比較例)	3100	0.73	1600	0.41
105 (本発明)	6300	1.5	5300	1.3
106 (本発明)	6100	1.4	5000	1.3
107 (本発明)	5900	1.4	5000	1.3
108 (本発明)	6800	1.6	5800	1.4
109 (本発明)	6500	1.6	5700	1.4
110 (本発明)	6000	1.5	5000	1.3
111 (比較例)	25000	8.3	5100	2.3
112 (比較例)	13000	5.2	7100	3.3
113 (比較例)	8900	3.4	3100	1.5
114 (比較例)	15000	5.3	8900	3.3
115 (比較例)	18000	5.7	9300	2.3
116 (比較例)	16000	5.5	8900	3.0
117 (本発明)	34000	10	25000	8.7
118 (本発明)	32000	10	23000	8.6
119 (本発明)	37000	13	28000	8.9
120 (本発明)	35000	11	26000	8.8
121 (本発明)	30000	9.8	22000	8.2
122 (本発明)	33000	10	22000	8.2
123 (本発明)	36000	11	26000	8.6

[0087] 【化14】

Q-1 
$$(CH-CH_2)$$
  $(CH-CH_2)$   $(CH-CH_2)$ 

【0088】表より、クマリン-6を発光材料として用い た発光素子101~104と比較して、本発明のポリマーを用 いた105~110の素子では、初期の発光輝度および加熱条 件下保存後の発光輝度両者ともに優れていることが分か る。また、三重項励起状態から発光可能な発光材料を用 較例と117~123の本発明のポリマーを用いた素子とを比 較すると、発光輝度、発光効率ともクマリン-6の場合よ りも各段に向上しており、三重項励起状態から発光可能 な発光材料を本発明のポリマーと合わせて用いること は、発光輝度、発光効率にとって有効であることが分か る。

### [0089]

【発明の効果】本発明のバラスト基を有するポリマーを いた素子である $111\sim123$ の結果において、 $111\sim116$ の比 40 含有することにより、高輝度、高発光効率の発光素子を 作製できることが明らかになった。更に、製膜性がよい ために高温保管後の輝度低下が小さく耐久性に優れた素 子を提供できる。